

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2002-110726  
(P2002-110726A)

(43) 公開日 平成14年4月12日 (2002. 4. 12)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード* (参考)
H 0 1 L 21/60	3 1 1	H 0 1 L 21/60 21/92	3 1 1 S 5 F 0 4 4 6 0 2 D 6 0 2 G 6 0 2 R 6 0 3 A
審査請求 有 請求項の数24 O L (全 9 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願2000-304708(P2000-304708)

(22) 出願日 平成12年10月4日 (2000. 10. 4)

(出願人による申告) 国等の委託研究の成果に係る特許出願 (平成11年度新エネルギー・産業技術総合開発機構「超高密度電子S I 技術の研究開発エネルギー使用合理化技術開発」に関する委託研究、産業活力再生特別措置法第30条の適用を受けるもの)

(71) 出願人 000004237

日本電気株式会社  
東京都港区芝五丁目7番1号

(71) 出願人 000006013

三菱電機株式会社  
東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(71) 出願人 000003078

株式会社東芝  
東京都港区芝浦一丁目1番1号

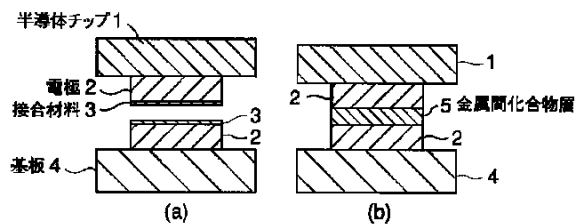
(74) 代理人 100071272

弁理士 後藤 洋介 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

(57)



(2)

1

2

10

20

30

40

50

(3)

3

4

10

20

30

40

50

(4)

5

6

10

20

30

40

50

(5)

7

8

10

20

30

40

50

(6)

9

10

10

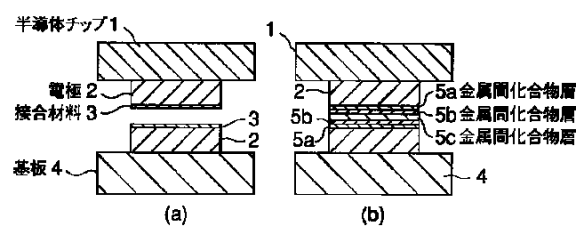
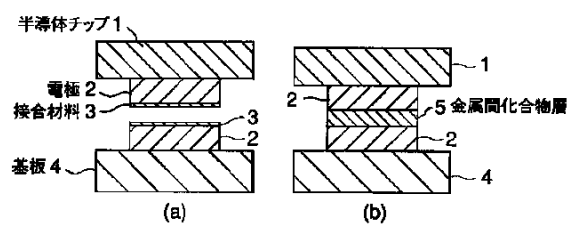
20

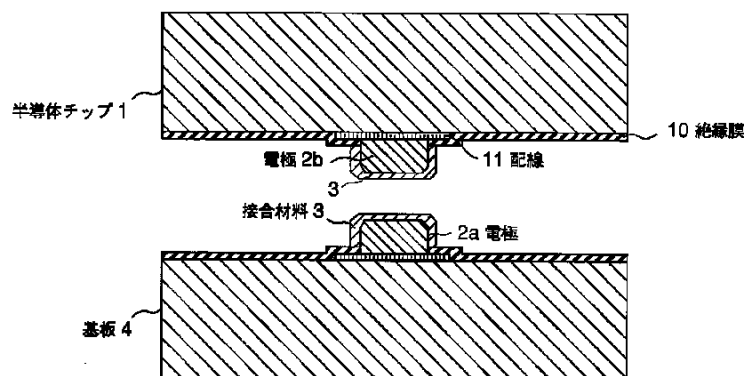
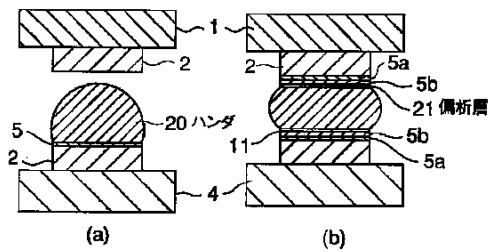
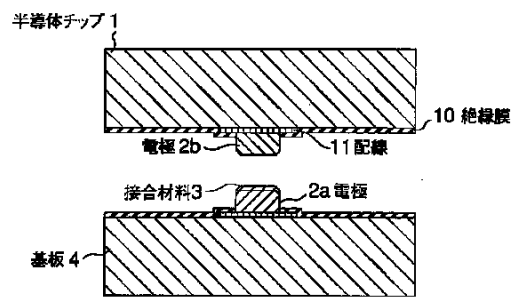
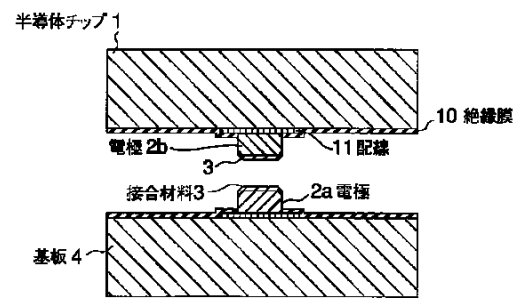
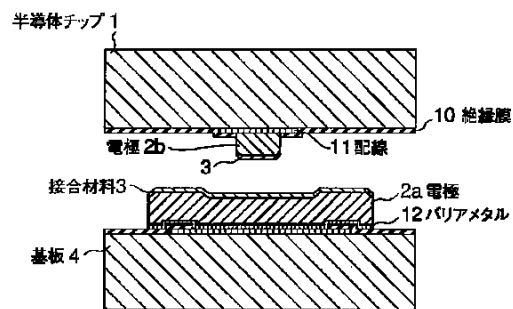
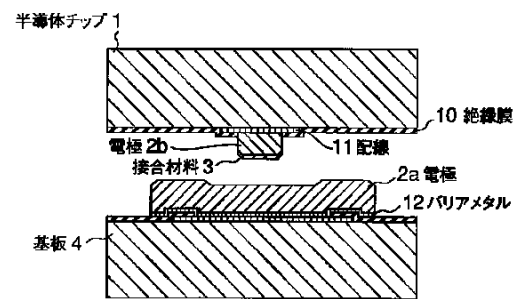
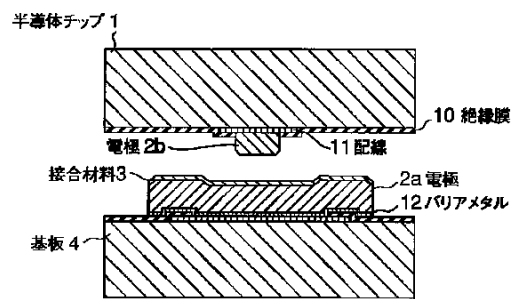
30

( )

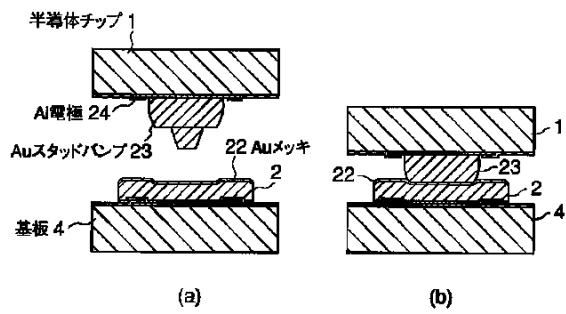
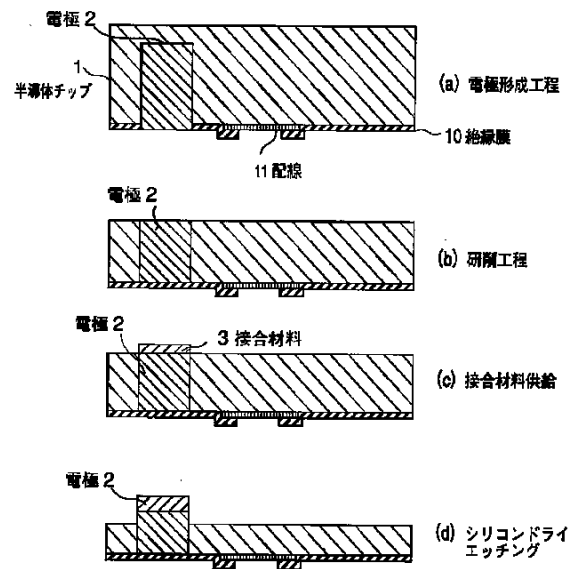
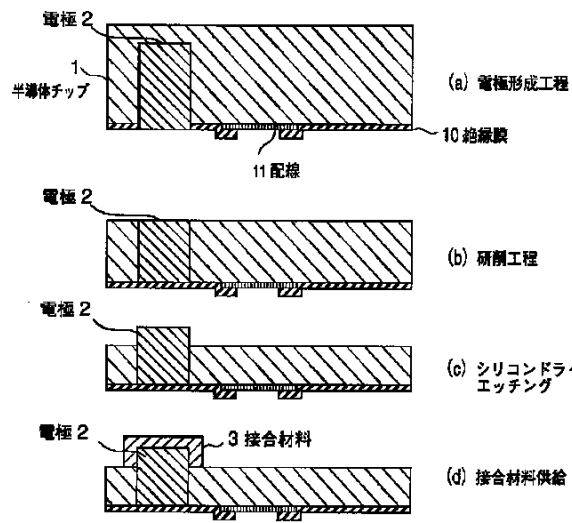
40

50









(5) Int. G. 7

21/92

(72

(72

72

(72

( 5F044 KK01 KK05 KK17 KK18 KK19  
LL05 QQ02 QQ03 QQ04 RR02